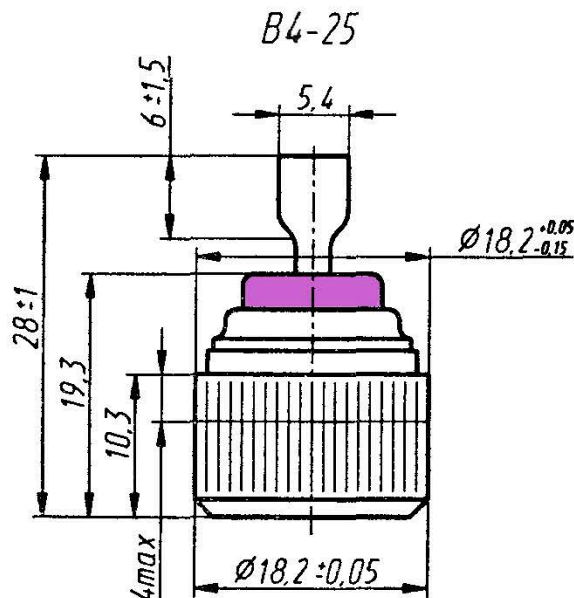


В4-25

Диод кремниевый, диффузионный, быстродействующий. Предназначен для работы в цепях статических преобразователей электроэнергии постоянного и переменного токов на частотах до 10 кГц. Выпускается в металлокерамическом цилиндрическом корпусе с жестким выводом и рифленной поверхностью для запрессовки в теплоотвод, прямой и обратной полярностей. Охлаждение воздушное естественное или принудительное. Обозначение типономинала и полярность выводов приводятся на корпусе. Масса диода не более 29 г.

Электрические параметры

Импульсное прямое напряжение, не более	1,7 В
Повторяющийся импульсный обратный ток при $T_n = +200\text{ }^\circ\text{C}$, $t_n = 10\text{ мс}$, не более	20 мА
Время обратного восстановления при $T_n = +200\text{ }^\circ\text{C}$, не более	6,3 мкс
Тепловое сопротивление переход—корпус, не более	0,6 $^\circ\text{C}/\text{Вт}$



Предельные эксплуатационные данные

Средний прямой ток при $T_K = +150^\circ\text{C}$, $f = 50$ Гц.....	25 А
Неповторяющийся импульсный прямой ток:	
при $T_n = +200^\circ\text{C}$, $t_n = 10$ мс	375 А
при $T = +25^\circ\text{C}$	400 А
Повторяющееся импульсное обратное напряжение при $T = +200^\circ\text{C}$, $t_n = 10$ мс	600 В
Неповторяющееся импульсное обратное напряжение при $T = +200^\circ\text{C}$, $t_n = 10$ мс	660 В
Постоянное обратное напряжение	400 В
Импульсное обратное напряжение	740 В
Температура перехода.....	$-60\dots+200^\circ\text{C}$
Температура корпуса.....	$+150^\circ\text{C}$

Монтаж диодов осуществляется запрессовкой в отверстие литого охладителя $\varnothing 18$ мм или штампованного охладителя $\varnothing 18$ мм с классом чистоты поверхности отверстия не менее 1,25, причем диод должен запрессовываться на глубину не менее 9 мм по высоте основания.

Запрессовку диода в отверстие необходимо производить через кондуктор, обеспечивающий непараллельность осей диода и отверстия не более 1° . Давление на основание диода при запрессовке должно осуществляться плоскостью с классом чистоты поверхности 1,25 и предельным отклонением от плоскости не более 10 мкм. Запрессовку необходимо производить плавно, без ударов, со скоростью 2...3 мм/с, с усилием 2500...9500 Н.

Не допускается приложение изгибающего усилия к выводу диода более 15 Н на расстоянии не более 2 мм от конца вывода.